

委 員 各 位

日本学術振興会 ワイドギャップ半導体
光・電子デバイス第 162 委員会
委員長 岸野 克巳

日本学術振興会 ワイドギャップ半導体光・電子デバイス第 162 委員会
第 99 回委員総会・第 103 回研究会 開催案内

日時：平成 29 年 4 月 28 日（金）

委員総会： 12:00 - 12:50

研究会： 13:00 - 17:30

場所： 金沢工業大学大学院 東京虎ノ門キャンパス13F 会議室
（東京メトロ銀座線 虎ノ門駅（1 番出口）より徒歩 8 分）
〒105-0002 東京都港区愛宕 1-3-4 愛宕東洋ビル
<http://www.kanazawa-it.ac.jp/tokyo/map.htm>

委員総会

議 題：

- （1）前回第 98 回委員総会 議事要録 承認について
- （2）委員の異動について
- （3）次回第 105 回研究会以降の研究会について
- （4）162 委員会運営内規の改訂について
- （5）International Workshop on Nitride Semiconductors 2018 (IWN2018)（石川県金沢市）の共催について
- （6）第 9 回ナノ構造・エピタキシャル講演会（北海道大学 7/13,14）の協賛について
- （7）その他

報告事項：

- （1）開催報告 日独西合同ワークショップ(スペイン、マヨルカ島)
- （2）開催報告 International Conference on Light Emitting Devices and their Applications'17(LEDIA17)
- （3）開催報告 『光の日』 合同シンポジウム
- （4）特別事業(シンポジウム) 第 100 回記念公開シンポジウムの開催概要について
- （5）特別事業(研究成果の刊行) 162 委員会 100 回記念研究会資料編纂について
- （6）開催案内 APWS2017 (2,017 年 9 月 24-27 日, 山東省・中国)
- （7）APWS2019 開催について
- （8）その他

研究会 主 題：「ワイドバンドギャップ半導体の絶縁膜／半導体界面制御」

「委員長挨拶・企画の趣旨説明」（13:00-13:05）

1. 「SiC 及び GaN 基板上 MOS 構造形成技術の類似点と相違点」（13:05-13:45）
渡部 平司（大阪大学）
2. 「GaN 系半導体の MOS 界面制御」（13:45-14:25）
橋詰 保（北海道大学）

3. 「第一原理計算による SiC 酸化機構および界面構造の解析」(14:25-15:05)

白石 賢二 (名古屋大学)

休憩 (15:05-15:30)

4. 「ホール効果測定による伝導帯近傍の SiC MOS 界面準位の評価」(15:30-16:10)

畠山 哲夫 (産業技術総合研究所)

5. 「走査型非線形誘電率顕微鏡(SNDM)による SiC MOS 界面評価」(16:10-16:50)

長 康雄 (東北大学)

6. 「GaN デバイスの開発状況と MOS 型デバイスの展望」(16:50-17:30)

中澤 敏志 (パナソニック株式会社)

<追記>

1. 4月28日の委員総会では、ご出席の回答をいただいた委員・同伴者に昼食をご用意いたします。
2. 当日は、出席名簿にご署名・交通費の要否・空路陸路の種別等のご記入をお願いいたします。
ご記入の無い場合は、学振からのお支払ができませんので、よろしく願いいたします。
3. 準備の都合上、委員総会・研究会の出欠回答を4月20日(木)までに日本学術振興会研究事業課 須賀 様 (jigyoka06@jsps.go.jp)宛に、必ずご連絡くださいますようお願いいたします。